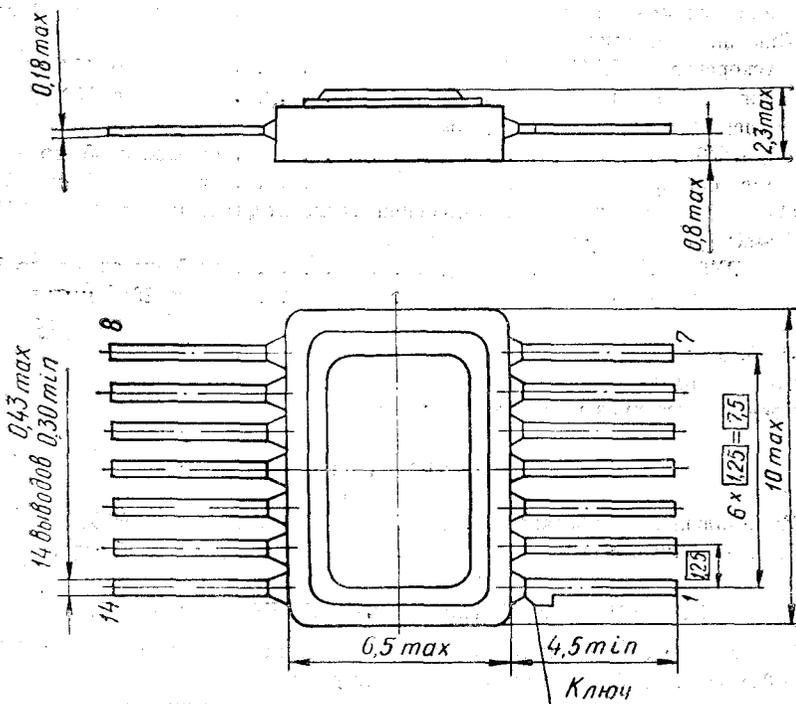


# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 134

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ



Масса — не более 0,35 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов показана условно.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация:

диапазон частот	от 1 до 5000 Гц
ускорение	до 40 г

Многократные удары:

ускорение	до 150 г
длительность удара	от 1 до 3 мс

## МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 134

### Общие данные

#### Одиночные удары:

ускорение . . . . .	до 1000 g
длительность удара . . . . .	от 0,2 до 1,0 мс

#### Линейные нагрузки:

ускорение 134ИПЗ . . . . .	до 150 g
для остальных . . . . .	до 500 g

#### Температура окружающей среды:

134РУ6 . . . . .	от минус 60 до +85° С
для остальных . . . . .	от минус 60 до +125° С

Многokrатные циклические изменения температуры от минус 60 до +125° С

#### Атмосферное давление:

134РУ6 . . . . .	от 5 мм рт. ст. до 3 атм
для остальных . . . . .	от 10 <sup>-3</sup> мм рт. ст. до 3 атм

Иней, роса.

Соляной туман.

Среда, зараженная плесневыми грибами.

### НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка* . . . . .	50 000 ч
Срок сохраняемости* . . . . .	25 лет

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—80 и требованиями, изложенными ниже.

Корпуса микросхем должны устанавливаться на печатную плату вплотную по всей поверхности дна корпуса.

Выводы закреплять методом припайки. При приклейке должно соблюдаться равномерное воздействующее усилие прижатия не более 0,5 кгс.

Не допускается воздействие крутящих и изгибающих моментов.

Запрещается кручение выводов микросхемы вокруг оси и изгиб выводов в плоскости корпуса микросхемы.

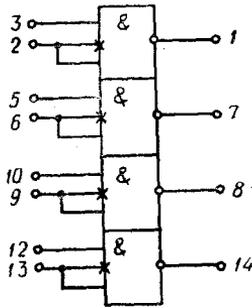
Микросхемы в блоках аппаратуры, работающей в условиях повышенной влажности, соляного тумана, инея и росы, должны быть покрыты тремя слоями лака УР-231 или ЭП-730.

В процессе эксплуатации подключение напряжения на выход микросхемы допускается только от источника питающего напряжения данной микросхемы через эквивалентное сопротивление.

\* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

- 1 — выход неинвентурирующий, Y1
- 2 — стробирующий вход, X2
- 3 — информационный вход, X1
- 4 — +5 В
- 5 — информационный вход, X3
- 6 — стробирующий вход, X4
- 7 — выход неинвентурирующий, Y2



- 8 — выход неинвентурирующий, Y3
- 9 — стробирующий вход, X6
- 10 — информационный вход, X5
- 11 — земля
- 12 — информационный вход, X7
- 13 — стробирующий вход, X8
- 14 — выход неинвентурирующий, Y4

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^\circ \text{C}$ )

Напряжение питания . . . . .	$5 \text{ В} \pm 10\%$
Ток потребления . . . . .	не более 1,2 мА
Входной ток низкого уровня по входам . . . . .	не более 300 мкА
Входной ток высокого уровня по входам . . . . .	не более 50 мкА
Длительность выходного импульса . . . . .	от 150 до 600 нс
Входная емкость по входам:	
информационным . . . . .	не более 3,5 пФ
стробирующим . . . . .	не более 7,0 пФ

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение на входе относительно «земли» . . . . .	5,5 В
Максимальное напряжение на выходе закрытой микросхемы . . . . .	4,5 В
Максимальное положительное напряжение, прилагаемое к выходу микросхем (при этом микросхемы обеспечивают втекающий ток не более 50 мкА) . . . . .	5,5 В
Минимальное отрицательное напряжение на входе микросхем при напряжении между эмиттерами, не превышающем 5,5 В . . . . .	1,5 В

Максимальная рассеиваемая мощность:

при температуре 100°С . . . . . 100 мВт

при температуре 125°С . . . . . 55 мВт

Максимальное тепловое сопротивление корпуса в  
воздухе без обдува . . . . . 0,45°С/мВт

Максимальная частота переключения микросхем . . . . . 3 МГц